
	<h2>SIS412DN-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIS412DN-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 12A 1212-8 PPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIS412DN-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 241806 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


### Spezifikationen

Teilenummer	SIS412DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 12A 1212-8 PPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	241806 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	24 mOhm @ 7.8A, 10V
Verlustleistung (max)	3.2W (Ta), 15.6W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SIS412DN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	435pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 12A (Tc) 3.2W (Ta), 15.6W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

SIS412DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS412DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS412DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIS412DN-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIS413DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 18A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SIS410DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SIS412DN-T1-GE3 QFN8</b> VISHAY SIS412DN-T1-GE3 QFN8 VISHAY</p>	 <p><b>SiS414DN</b> Vishay SiS414DN Vishay</p>
 <p><b>SIS412DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A 1212-8 PPAK</p>	 <p><b>SIS410DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p><b>SIS412DN-T1-E3</b> VISHAY SIS412DN-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SIS410DN</b> VB SIS410DN VB</p>

### SIS412DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SIS412DN-T1-GE3 Datenblatt	SIS412DN-T1-GE3-Datenblätter	SIS412DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIS412DN-T1-GE3
SIS412DN-T1-GE3 Electronic	SIS412DN-T1-GE3 Komponenten	SIS412DN-T1-GE3-Verteiler	SIS412DN-T1-GE3-Bild	SIS412DN-T1-GE3 Teil	SIS412DN-T1-GE3 Teil
SIS412DN-T1-GE3 Preis	SIS412DN-T1-GE3 Hersteller	SIS412DN-T1-GE3 Bild	SIS412DN-T1-GE3 Aktie	SIS412DN-T1-GE3 Inventar	SIS412DN-T1-GE3 Inventar
SIS412DN-T1-GE3 Neu	SIS412DN-T1-GE3 Original	SIS412DN-T1-GE3 garantiert	SIS412DN-T1-GE3 RFQ	SIS412DN-T1-GE3 Online bestellen	SIS412DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited